

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
младшего научного сотрудника
в лаборатории Полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей
Вакансия VAC_PTI_JSР5_7

Тематика исследований

Исследования в области прямой ионной литографии полупроводниковых гетероструктур, в том числе исследование модификации физических свойств лазерных гетероструктур радиационными дефектами, образующимися в процессе ионно-лучевой литографии.

Трудовая деятельность

Проведение научных исследований и разработок под руководством заведующего лабораторией согласно государственному заданию и планам НИР по утвержденным целевым программам. Теоретическое и экспериментальное исследование модификации физических свойств лазерных гетероструктур, радиационными дефектами, образующимися в процессе ионно-лучевой литографии. Выявление доминирующих технологических параметров, влияющих на оптические, электрические и механические свойства структур. Формулировка выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений. Повышение квалификации, выступление с докладами на научных семинарах и конференциях, подготовка публикаций по результатам исследований.

Особенности трудовой деятельности

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к их квалификации.

-- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:

Web of Science (шт.) не менее 5, Scopus (шт.) не менее 5.

-- Опыт научной работы: не менее 5 лет

-- Индекс Хирша не ниже 1

-- За последние 5 лет: участие в не менее чем 4 проектах, поддержанных отечественными или зарубежными научными фондами, а также личное участие с докладами в не менее чем 3 всероссийских или международных конференциях.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;

характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).